

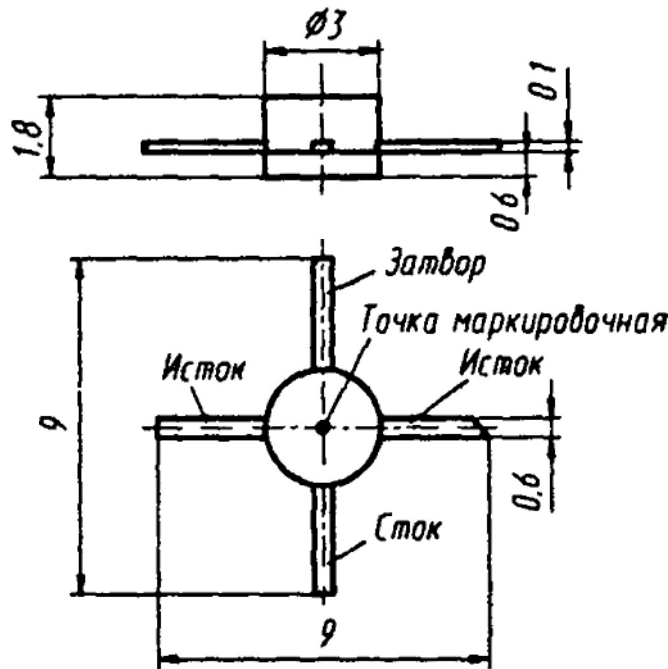
ЗП321А-2

Транзистор полевой арсенидгаллиевый планарный ионно легированный с каналом л-типа и барьером Шотки сверхвысокочастотный усилительный с нормированным коэффициентом шума на частоте 8 ГГц. Предназначен для применения во входных и последующих каскадах малозумящих усилителей герметизированной радиоприемной аппаратуры. Бескорпусный на керамическом кристаллодержателе с гибкими полосковыми выводами и керамической крышкой. Тип прибора указывается в этикетке.

Масса транзистора не более 0,15 г.

Изготовитель — завод «Пульсар», г. Москва.

ЗП321А-2



Электрические параметры

Минимальный коэффициент шума	
при $U_{си} = 2$ В, $I_c = 8$ мА, $f = 8$ ГГц, не более ..	3,5 дБ
типичное значение	2,8* дБ
Оптимальный коэффициент усиления по мощности при $U_{си} = 2$ В, $I_c = 8$ мА, $f = 8$ ГГц,	
не менее	3,5 дБ
типичное значение	6,3* дБ
Крутизна характеристики при $U_{си} = 2$ В,	
$I_c = 8$ мА, $f = 5$ МГц, не менее	5 мА/В

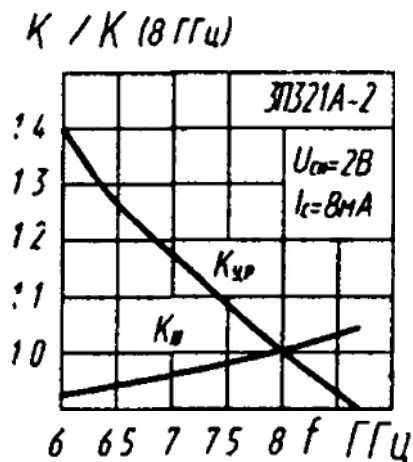
типичное значение.....	16* мА/В
Напряжение отсечки при $U_{си} = 2,5$ В, $I_c = 0,1$ мА	1,5*...3*... 4,5* В
Ток утечки затвора при $U_{зи} = 2,5$ В, не более: $T = -60$ °С и $+25$ °С	1 мкА
$T = +70$ °С	10 мкА
Коэффициент отражения входной цепи транзистора в схеме ОИ при $U_{си} = 2,5$ В, $I_c = 10$ мА, $f = 8$ ГГц:	
модуль	-4* дБ
фаза	-150°*
Коэффициент обратной передачи напряжения транзистора в схеме ОИ при $U_{си} = 2,5$ В, $I_c = 10$ мА, $f = 8$ ГГц:	
модуль	-17* дБ
фаза	84°*
Коэффициент прямой передачи напряжения транзистора в схеме ОИ при $U_{си} = 2,5$ В, $I_c = 10$ мА, $f = 8$ ГГц:	
модуль	3* дБ
фаза	60°*
Коэффициент отражения выходной цепи транзистора в схеме ОИ при $U_{си} = 2,5$ В, $I_c = 10$ мА, $f = 8$ ГГц:	
модуль	-4,5* дБ
фаза	-82°*

Предельные эксплуатационные данные

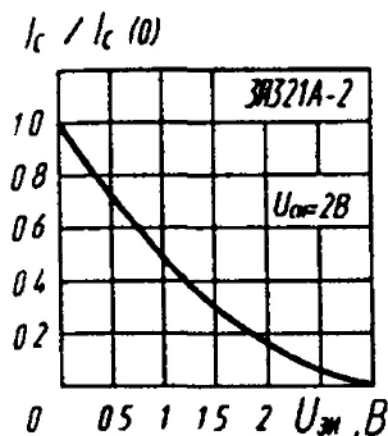
Напряжение сток—исток	3 В
Напряжение затвор—исток	3 В
Напряжение затвор—сток	4 В
Потенциал статического электричества	10 В
Постоянная рассеиваемая мощность	30 мВт
Температура окружающей среды	-60...+70 °С

Допускается однократный изгиб выводов не ближе 1 мм от кристаллодержателя с радиусом закругления не менее 1,5 мм.

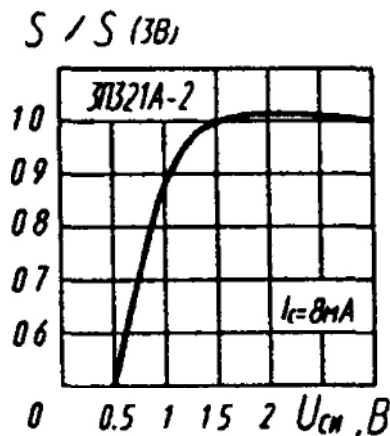
Минимально допустимое расстояние от места пайки выводов до кристаллодержателя 2 мм при температуре пайки $+240 \pm 10$ °С и длительности не более 3 с. Допускается пайка выводов на расстоянии 1 мм от кристаллодержателя при температуре не выше $+150$ °С, длительности не более 3 с и отводе теплоты от вывода между местом пайки и кристаллодержателем.



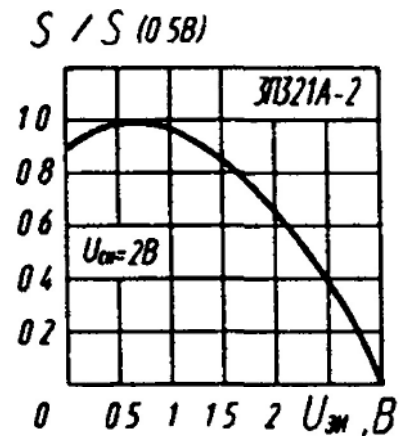
Зависимости коэффициентов шума и усиления от частоты



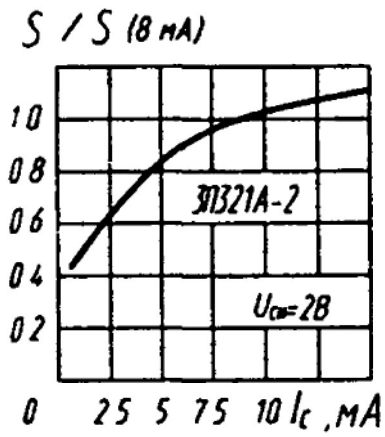
Проходная характеристика



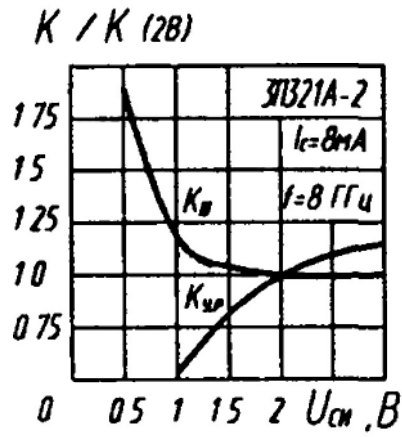
Зависимость крутизны характеристики от напряжения сток—исток



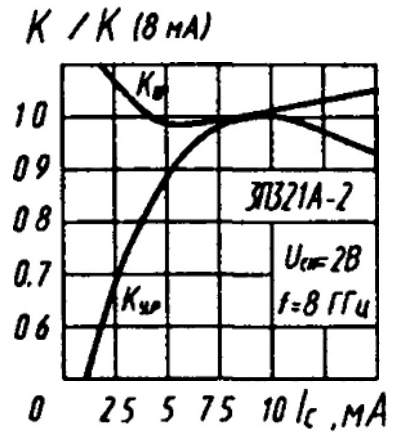
Зависимость крутизны характеристики от напряжения затвор—исток



Зависимость крутизны характеристики от тока стока



Зависимости коэффициентов шума и усиления от напряжения сток—исток



Зависимости коэффициентов шума и усиления от тока стока